

# Silicon Diode

## **BAY26**

High Voltage Diode

3000V / 50mA

# DATASHEET

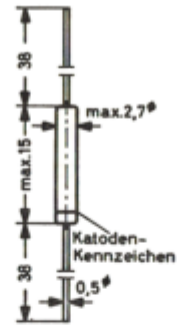
OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

## BAY 23 ... BAY 26

### Diffundierte Silizium-Hochspannungs-Flächendiode

Glasgehäuse DO-7 lang  
Gewicht ca. 0,3 g  
Maße in mm



### Grenzwerte

Typ	Sperrspannung $U_R$ V
<b>BAY 23</b>	1000
<b>BAY 24</b>	1500
<b>BAY 25</b>	2000
<b>BAY 26</b>	3000

Stoßspitzenspannung bei  $t < 1$  ms

<b>BAY 23</b>	$U_{RSM}$	1500	V
<b>BAY 24</b>	$U_{RSM}$	2250	V
<b>BAY 25</b>	$U_{RSM}$	3000	V
<b>BAY 26</b>	$U_{RSM}$	4500	V

Richtstrom in Einwegschaltung  
mit  $R$ -Last, bei  $T_U = 45$  °C

$I_0$  50 mA

Verlustleistung bei  $T_U = 45$  °C

$P_{tot}$  250 mW

Sperrschichttemperatur

$T_j$  150 °C

### Kennwerte bei $T_j = 25$ °C

Durchlaßspannung bei  $I_F = 80$  mA

$U_F$  <3 V

Sperrstrom

**BAY 23** bei  $U_R = 1000$  V

$I_R$  <1  $\mu$ A

**BAY 24** bei  $U_R = 1500$  V

$I_R$  <1  $\mu$ A

**BAY 25** bei  $U_R = 2000$  V

$I_R$  <1  $\mu$ A

**BAY 26** bei  $U_R = 3000$  V

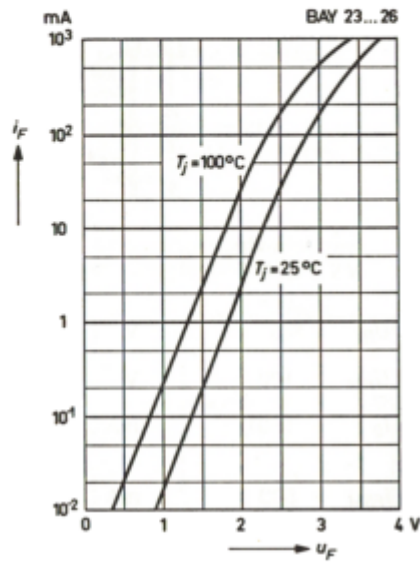
$I_R$  <3  $\mu$ A

Wärmewiderstand  
Sperrschicht - umgebende Luft

$R_{thU}$  <0,42 K/mW

## BAY 23 ... BAY 26

**Durchlaßkennlinien**  
 $T_j = 25\text{ °C}$ ,  $T_j = 100\text{ °C}$



**zul. Durchlaß-Gleichstrom**  
**in Abhängigkeit von der**  
**Einschaltdauer,**  
 ausgehend von  $T_j = 25\text{ °C}$

